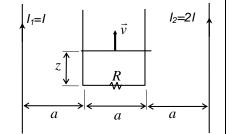


Tercer parcial de FFI **16 de Enero de 2017** Curso 2016/17

Dpto. Física Aplicada

1. La espira rectangular de la figura, de lados a y z, se encuentra en el mismo plano que dos conductores rectilíneos, indefinidos y paralelos, situados como se indica en la figura, por los cuales circulan intensidades I_1 = I_2 = I_2 = I_3 =I



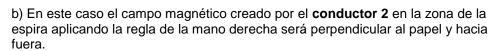
- a) La expresión del flujo magnético a través de la espira del campo magnético que crea el hilo 1.
- b) La expresión del flujo magnético a través de la espira del campo magnético que crea el hilo 2.
- c) La expresión del flujo magnético total a través de la espira.
- d) Fuerza electromotriz inducida en la espira.
- e) Intensidad de corriente en la espira, **justificando** su sentido, si la resistencia eléctrica es R.
- f) Coeficiente de inducción mutua entre el hilo 2 y la espira rectangular.

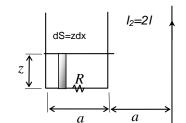
3 puntos

- a) El campo magnético que crea una corriente que circula por un conductor rectilíneo indefinido a una distancia x del conductor, es $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$; La dirección del campo magnético originado por una corriente es perpendicular a la dirección de la corriente ($d\bar{\ell}$) y a la dirección de la línea que une la corriente con el punto problema (\bar{r}), ley de Biot y Savart $d\bar{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\bar{\ell} \times \bar{r}}{r^3}$. En este caso el campo magnético creado por el **conductor 1** en la zona de la espira aplicando la regla de la mano derecha a dicho producto vectorial será perpendicular al papel y hacia dentro.
 - $\vec{B} = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} \left(-\vec{k} \right)$, siendo *x* la distancia de cada punto al conductor 1.

Al calcular el flujo deberemos tomar una superficie elemental en la que el campo sea uniforme: una superficie rectangular de altura z y amplitud dx en la que el valor de B es constante, y que podremos desplazar sobre la espira desde una distancia a del conductor hasta una distancia a. De este modo, el elemento de superficie viene dado por dS = zdx. Consideramos el sentido del vector superficie elemental contrario al del del campo (podríamos haber considerado lo contrario),

así,
$$\Phi_1 = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\int_{S} B dS = -\int_{a}^{2a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} z dx = -\frac{\mu_0 I z}{2\pi} \ln\left(\frac{2a}{a}\right) = -\frac{\mu_0 I z}{2\pi} \ln 2$$
 (flujo entrante)





- $\vec{B} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi x} (\vec{k}) = \frac{\mu_0 2I}{2\pi x} (\vec{k})$, siendo *x* la distancia de cada punto al conductor 2.
- El flujo tendrá signo contrario al creado por el conductor 1.

$$\Phi_2 = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{S} BdS = \int_{a}^{2a} \frac{\mu_0 2I}{2\pi x} z dx = \frac{\mu_0 2Iz}{2\pi} \ln\left(\frac{2a}{a}\right) = \frac{\mu_0 2Iz}{2\pi} \ln 2$$
 (flujo saliente)

c) El flujo magnético total a través de la espira será la suma algebraica de los dos:

$$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2 = -\frac{\mu_0 I z}{2\pi} \ln 2 + \frac{\mu_0 2 I z}{2\pi} \ln 2 = \frac{\mu_0 I z}{2\pi} \ln 2$$
 (flujo saliente)

d) La fuerza electromotriz inducida la calculamos utilizando la ley de Faraday. Teniendo en cuenta que la única variable que depende del tiempo es z, el valor absoluto de la fem será:

$$\left|\varepsilon_{i}\right| = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{\mu_{0}I}{2\pi}\ln(2)\frac{dz}{dt} = \frac{\mu_{0}I}{2\pi}\ln(2)v$$

e) Aplicamos la ley de Lenz para obtener el sentido de la corriente inducida: al mover el lado superior z aumenta, y el flujo saliente total, que es proporcional a z, aumentará también. La corriente se opondrá a esta variación creando un campo en sentido contrario al total. Aplicando la regla de la mano derecha a la espira, el sentido de la corriente inducida es el de las agujas del reloj (horario). Su valor es:

$$i = \frac{\varepsilon_i}{R} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \ln(2) v$$

f) El coeficiente de inducción mutua entre la espira y el hilo 2, es la relación entre \emptyset_2 e I_2 :

$$M = \frac{\emptyset_2}{I_2} = \frac{\frac{\mu_0 2Iz}{2\pi} \ln 2}{2I} = \frac{\mu_0 z}{2\pi} \ln 2$$

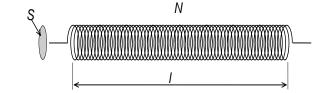
- 2. Un solenoide formado por 20000 espiras tiene una sección 5 cm² y una longitud de 10 cm. Si el solenoide es recorrido por una corriente de 1 A, calcula:
- a) El campo magnético en su interior, admitiendo que es uniforme dentro del solenoide.
- b) El flujo magnético que atraviesa el solenoide.
- c) Su coeficiente de autoinducción.

1,5 puntos

a)
$$B = \frac{\mu_{0NI}}{l} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20.000 \times 1}{0.1} = 0.25 T$$

(0,5 puntos)

b)
$$\Phi = N \int_{S} B dS = NB \int_{S} dS = NBS$$



$$\emptyset = NBS = 20.000 \times 0.25 \times 5 \times 10^{-4} = 2.5 \text{ W (0.5 puntos)}$$

c)
$$L = \frac{\emptyset}{I} = \frac{2.5}{1} = 2.5 H$$
 (0.5 puntos)

- **3.** Por un circuito compuesto por dos elementos puros en serie alimentados por una fuente de tensión $u(t) = 40\cos(1000t 20^\circ) V$, circula una intensidad de corriente $i(t) = 2\cos(1000t + 10^\circ) A$.
- a) Determina los mencionados elementos y dibuja el triángulo de impedancias.
- b) Determina la tensión en bornes de dichos elementos.

2 puntos

a) Fijándonos en el desfase tensión- intensidad $\varphi = \varphi_u - \varphi_i = -20^\circ - 10^\circ = -30^\circ$ deducimos que se trata de una resistencia y un condensador, al ser el desfase negativo.

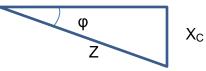
Del triángulo de impedancias también conocemos Z,

$$Z = \frac{u_m}{l_m} = \frac{40}{2} = 20 \ \Omega$$

$$R = Z\cos\varphi = 20\cos 30^\circ = 17,32 \ \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{C\omega} = Z\sin\varphi = 20\sin 30^\circ = 10 \ \Omega$$

$$C = \frac{1}{10,1000} = 100 \ \mu F$$



b) $u_R(t) = RI_m cos(1000 + 10^\circ) = 34,64 cos(1000 + 10^\circ) V$ $u_c(t) = \frac{1}{Co}I_m cos(1000t - 80^\circ) = 20 cos(1000t - 80^\circ) V$

- (0,5 puntos)
- $u_c(t) = \frac{1}{C\omega} I_m \cos(1000t 80^\circ) = 20\cos(1000t 80^\circ)V$ (0,5 puntos)
- **4.** Un semiconductor extrínseco tipo n está formado por Si dopado con 10^{20} átomos de Sb/m³ (Sb es un donador de ē). La concentración intrínseca del Si a 300 K es n_i =1,5·10¹⁶ m⁻³ y a 500 K n_i = 3,7·10²⁰ m⁻³
- a) Calcular la concentración de electrones y huecos en dicho semiconductor a 300 K.
- b) Calcular la concentración de electrones y huecos en dicho semiconductor a 500 K.
- c) Razona si la carga eléctrica neta del semiconductor en ambos casos en es positiva, negativa, o neutra.
 - 2 puntos

 (N_D) es muy grande comparado con la concentración intrínseca (n_i) $(10^{20}>>>10^{16})$, entonces

$$n \approx N_D = 10^{20} e^-/m^3$$
 $p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{1.5^2 \cdot 10^{32}}{10^{20}} = 2.25 \cdot 10^{12} \, h/m^3$ (0.8 puntos)

b) En este caso debemos resolver el sistema de ecuaciones

$$n \cdot p = n_i^2 \Rightarrow n \cdot p = (3.7 \cdot 10^{20})^2$$

 $N_A + n = N_D + p$
 $n = 10^{20} + p$, resultando,
 $n = 4.2 \cdot 10^{20} e^-/m^3$
 $p = 3.2 \cdot 10^{20} e^-/m^3$

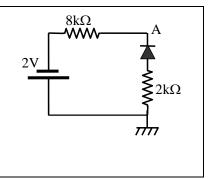
(0,8 puntos)

c) Neutra (ley de neutralidad eléctrica)

(0,4 puntos)

5. Dado el circuito de la figura, suponiendo una tensión de codo para el diodo de 0,6 V y resistencia 5 Ω , calcula:

- a) La corriente que circula por el circuito, utilizando las tres aproximaciones del diodo
- b) La tensión del punto A.



1,5 puntos

El sentido de la corriente será antihorario y su valor dependerá de la aproximación utilizada:

1ª aproximación: Diodo ideal. Tensión umbral y resistencia del diodo nulas.

$$i = \frac{2}{10} = 0.2 \, mA$$

 2^a aproximación: $V_u = 0.6 V$ r = 0

$$i = \frac{2 - 0.6}{10} = 0.14 \, mA$$

 3^a aproximación: $V_u = 0.6 V$ $r = 5 \Omega$

$$i = \frac{2 - 0.6}{10 + 0.005} = 0.1399 mA$$
 (1 punto)

El potencial del punto A calculado en el sentido de la corriente, utilizando la intensidad obtenida mediante la 2º aproximación, es:

$$V_A - V_T = I \sum_{r} R - (\sum_{r} \varepsilon) = 8 \cdot 0.14 - 2 = -0.88V$$

Si lo hubiéramos calculado en sentido contrario por supuesto obtenemos el mismo resultado:

$$V_A - V_T = I \sum R - \left(\sum \varepsilon\right) = -2 \cdot 0.14 - 0.6 = -0.88V$$
 (0.5 puntos)

Formulario

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{\ell} \times \vec{r}}{r^3} \qquad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} \qquad B = \frac{\mu_0 NI}{l}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

$$B = \frac{\mu_0 NI}{l}$$

$$\Phi = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\left|\varepsilon\right| = \frac{d\phi}{dt}$$

$$\phi = L \cdot I$$

$$\phi = M \cdot I$$

$$W_L = \frac{1}{2} L \cdot I^2$$

$$\left|\varepsilon\right| = \frac{d\phi}{dt}$$
 $\phi = L \cdot I$ $\phi = M \cdot I$ $W_L = \frac{1}{2}L \cdot I^2$ $\mu_0 = 4\pi 10^{-7} \text{(S.I.unidades)}$

$$\varphi = \varphi_u - \varphi$$

$$X_L = L\omega$$

$$X_C = \frac{1}{C\omega}$$

$$tg\varphi = \frac{L\omega - 1/C\alpha}{R}$$

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i \qquad \qquad X_L = L\omega \qquad \qquad X_C = \frac{1}{C\omega} \qquad \qquad tg\varphi = \frac{L\omega - 1/C\omega}{R} \qquad Z = \frac{U_m}{I_m} = \sqrt{R^2 + \left(L\omega - 1/C\omega\right)^2}$$

$$n \cdot p = n_i^2$$

$$n \cdot p = n_i^2 \qquad \qquad N_A + n = N_D + p$$